

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成16年9月30日(2004.9.30)

【公開番号】特開2002-40962(P2002-40962A)

【公開日】平成14年2月8日(2002.2.8)

【出願番号】特願2001-83342(P2001-83342)

【国際特許分類第7版】

G 0 9 F 9/30

G 0 2 F 1/1368

G 0 9 F 9/00

H 0 1 L 21/3205

H 0 1 L 29/786

【F I】

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 F 9/30 3 4 9 C

G 0 2 F 1/1368

G 0 9 F 9/00 3 4 8 C

H 0 1 L 21/88 Z

H 0 1 L 29/78 6 1 2 C

【手続補正書】

【提出日】平成15年9月16日(2003.9.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

データ線と走査線の交差に対応して設けられた画素トランジスタと、前記スイッチング素子の対応して設けられた画素電極と、前記画素トランジスタと前記データ線との間の層に形成され、前記画素電極と前記画素トランジスタの半導体層との間を電氣的に接続する蓄積容量電極を成す中間電極と、前記画素トランジスタのゲート電極と同一材料でなる第1配線と、前記中間電極と同一材料でなる第2配線と、前記データ線と同一材料でなる第3配線とを含む配線で、前記画素電極を駆動する周辺回路を構成することを特徴とする電気光学装置。

【請求項2】

前記第1配線材料と前記第2配線材料はポリシリコンからなることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。

【請求項3】

前記第1配線材料はポリシリコンからなり、前記第2配線材料は、チタン、クロム、タングステン、タンタル、モリブデン又は鉛の単体、若しくはこれらの合金、金属シリサイドであることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。

【請求項4】

前記第3配線は、アルミニウムからなることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電気光学装置。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。

。

【請求項6】

画素トランジスタのゲート電極と、前記画素トランジスタのを駆動するための周辺回路に用いる第1配線を形成する工程と、
前記画素電極の半導体層に電氣的に接続される蓄積容量電極を成す中間電極と、前記周辺回路に用いる第2配線を形成する工程と、
前記画素電極の半導体層に電氣的に接続されるデータ線と、前記周辺回路に用いる第3配線を形成する工程と、
前記容量電極に接続される画素電極を形成する工程と、
を備えることを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【課題を解決するための手段】

上述した目的を達成するため、本件の電気光学装置にあっては、データ線と走査線の交差に対応して設けられた画素トランジスタと、前記スイッチング素子の対応して設けられた画素電極と、前記画素トランジスタと前記データ線との間の層に形成され、前記画素電極と前記画素トランジスタの半導体層との間を電氣的に接続する蓄積容量電極を成す中間電極と、前記画素トランジスタのゲート電極と同一材料でなる第1配線と、前記中間電極と同一材料でなる第2配線と、前記データ線と同一材料でなる第3配線とを含む配線で、前記画素電極を駆動する周辺回路を構成することを特徴とする。